

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-271611

(43)Date of publication of application : 06.11.1990

(51)Int.Cl.

H01L 21/20

H01L 21/263

(21)Application number : 01-093759

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 13.04.1989

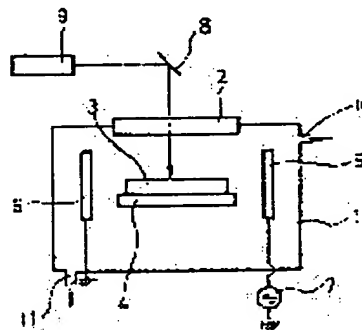
(72)Inventor : NAKAMURA NOBORU
KURIYAMA HIROYUKI
TSUDA SHINYA
NAKANO SHOICHI

(54) PRODUCTION OF POLYCRYSTALLINE SILICON

(57)Abstract:

PURPOSE: To compensate dangling bond with hydrogen for improving mobility by a method wherein amorphous silicon is laser-annealed in hydrogen containing atmosphere.

CONSTITUTION: Amorphous silicon 3 to be crystallized is set in a chamber 1, and after evacuation hydrogen gas is fed from an inlet port 10. Then hydrogen plasma is generated between electrodes 5, 6, and laser beam (wavelength of 308nm) of an XeCl excimer laser 9 is radiated to the amorphous silicon 3 through a window 2 to have it crystallized. By thus performing laser annealing in hydrogen atmosphere, dangling bond is compensated by hydrogen and mobility is increased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪ 公開特許公報(A) 平2-271611

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 21/20
21/263

識別記号 庁内整理番号
7739-5F

⑬ 公開 平成2年(1990)11月6日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全2頁)

⑭ 発明の名称 多結晶シリコンの生産方法

⑮ 特 願 平1-93759

⑯ 出 願 平1(1989)4月13日

⑰ 発 明 者	中 村 昇	大阪府守口市京阪本通2丁目18番地	三洋電機株式会社内
⑱ 発 明 者	栗 山 博 之	大阪府守口市京阪本通2丁目18番地	三洋電機株式会社内
⑲ 発 明 者	津 田 信 哉	大阪府守口市京阪本通2丁目18番地	三洋電機株式会社内
⑳ 発 明 者	中 野 昭 一	大阪府守口市京阪本通2丁目18番地	三洋電機株式会社内
㉑ 出 願 人	三洋電機株式会社	大阪府守口市京阪本通2丁目18番地	
㉒ 代 理 人	弁理士 西野 卓嗣	外2名	

明 細 書

1. 発明の名称 多結晶シリコンの生産方法

2. 特許請求の範囲

1. 非品質シリコン半導体にレーザ光線を照射することによって、当該非品質シリコン半導体を、アニールして結晶化させる多結晶シリコンの生産方法において、

前記非品質シリコン半導体は、水素が含有される雰囲気中で、レーザ光線が照射されることを特徴とする多結晶シリコンの生産方法、

2. 水素がプラズマ状態を呈している請求項1記載の多結晶シリコンの生産方法、

3. 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は、トランジスタ、光起電力装置等の半導体デバイスに使用される多結晶シリコンの生産方法に関するものである。

(ロ) 従来の技術

薄膜トランジスタに用いられる多結晶シリコンの生産方法として、非品質シリコンを真空中や、

大気中でレーザアニールする方法が存在する(例えば、坂島他、第46回応用物理学会学術講演会講演予稿集P704、2a-2A-3)。

(ハ) 発明が解決しようとする課題

従来の生産方法による多結晶シリコンの質は悪く、電解効果法によって求められた移動度は、約100 cm²/vsec程度であり、多結晶シリコンのそれに比べて、大変小さな値となっている。

これは、結晶粒内および結晶粒界に、多数のダングリングボンドが存在するためであると考えられる。

本発明は、かかる従来の技術の課題に鑑みてなされたもので、移動度の大きな多結晶シリコンを生産する方法に関する。

(ニ) 課題を解決するための手段

本発明は、非品質シリコン半導体にレーザ光線を照射することによって当該非品質シリコン半導体をアニールして結晶化させる多結晶シリコンの生産方法において、前記非品質シリコン半導体は、水素が含有される雰囲気中でレーザ光線が照

を特徴とするものである。

作用

・ゲアニールを水素雰囲気中に行なうと、ダングリングボンドが水素で補償される。

(ハ) 実施例

第1図は本発明方法を実行するための装置の概略図である。

これらの図において、1はチャンバで、レーザー光線を送るための透光性の窓2が設けられている。そして、前記窓2の下部には、非品質シリコン3が設置される支持台4が設けられ、当該支持台4を挟むように、電極5、6が対向配備されている。7は前記電極5、6に高周波電力を供給するための電源である。

前記窓2の上方には、反射鏡8が設けられ、その左方にXeClエキシマレーザー9が偏置されている。また、前記チャンバ1には、当該チャンバ1内に水素を導入する導入口10と、チャンバ1から排気する排気口11が設けられている。

而して、チャンバ1に結晶化させる非品質シリ

第1表 移動度の比較

レーザーアニールの方法	移動度 ($\text{cm}^2/\text{v}\cdot\text{sec}$)
本発明 水素中	150
" 水素プラズマ中	210
従来例 未処理	90
" 水素プラズマ処理	110

(ト) 発明の効果

第1表からも明らかなように、本発明では、非品質シリコンが、水素の含有されている雰囲気中レーザーアニールされるので、ダングリングボンドが水素で補償され、移動度が向上する。

図面の簡単な説明

第1図は本発明方法を実行するための装置の概略図である。

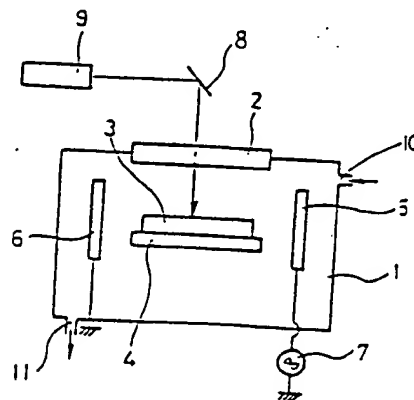
1…チャンバ、2…窓、3…非品質シリコン、4…支持台、5、6…電極、7…電源、8…反射鏡、9…レーザー、10…導入口、11…排出口。

特開平2-271611(2)

コン3をセットし、真空引き後、水素ガスを導入口10から導入する。その後、電極5、6間で水素プラズマを発生させ、XeClエキシマレーザー9のレーザー光線(波長308nm)を、窓2を通して非品質シリコン3に照射し、結晶化を実行する。水素プラズマの代表的条件は、水素流量20~200sccs、圧力0.1~1Torr、高周波電力10~100w/cm²である。また、XeClエキシマレーザー9の強度は150~300J/cm²である。

第1表に、本発明により形成した多結晶シリコンの、電界効果法により測定した移動度を、従来方法によるもの、及び従来方法により形成した多結晶シリコンを水素プラズマ処理したものとともに示す。この表からも明らかなように、本発明方法により生成したものの移動度は、従来方法によるものの約1.5倍から2倍になる。

第1図



⑤Int. Cl.

H 01 L 21/20
21/31

④発明の名称 半

⑥発明者 田

⑦出願人 三

⑧代理人 井

明

1. 発明の名称

半導体製造装置

2. 特許請求の範囲

化学気相成長法を用いた装置において、反応ガスを供給することと、排気口及び真空に保つことを特徴とする。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

この発明は、半導体製造装置、化学気相成長法(CVD)装置製造装置に関するものである。(従来の技術)

第2図は、従来の第3製造装置の構造を模式的図において01はヘッド、02は半導体基板、03は排気口、04はヘッドカバー、次に動作について説明